

Diário Oficial Nº 221, segunda-feira, 19 de novembro de 2007

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 202, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52000.016749/2007-57, de 15 de outubro de 2007, resolvem:

Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para os produtos COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA PADRONIZADOS, industrializados na Zona Franca de Manaus, estabelecidos pela Portaria Interministerial MIR/MICT/MCT nº 67, de 2 de maio de 1994, passam a ser conforme os artigos seguintes:

Art. 2º COMPONENTES SEMICONDUTORES e DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS:

I - montagem de pastilha semicondutora, não encapsulada;

II - encapsulamento da pastilha montada;

III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e IV - marcação (identificação).

§ 1º Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora no País.

§ 2º Os circuitos integrados monolíticos projetados no País ficam dispensados de realizar as fases constantes dos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 3º COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO:

I - processamento físico-químico sobre o substrato;

II - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e

III - marcação (identificação).

Parágrafo único. Para a produção de circuitos integrados híbridos, ficam dispensados de atender ao disposto no caput do art. 2º desta Portaria os componentes semicondutores utilizados como insumos na produção dos mesmos.

Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:

I - processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;

II - encapsulamento da pastilha montada; e

III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico.

Art. 5º MÓDULOS DE MEMÓRIA PADRONIZADOS:

I - montagem de pastilha semicondutora, não encapsulada;
II - encapsulamento da pastilha montada;
III - marcação (identificação);
IV - montagem do módulo; e
V - gravação da memória do tipo Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM, testes elétricos e funcionais, etiquetagem para identificação dos módulos.

§ 1º As etapas constantes dos incisos I, II, III e IV deste artigo poderão ser dispensadas para os módulos de memória padronizados nos percentuais máximos sobre o total dos módulos de memória produzidos em cada ano-calendário de acordo com o seguinte cronograma:

I - Para o ano de 2007: 5% (cinco por cento); e

II - Para o ano de 2008 em diante: 2% (dois por cento).

§ 2º Poderão ser utilizados circuitos integrados monolíticos do tipo memória de acesso aleatório (Random Access Memory - RAM) importados para montagem local dos módulos de memória, nas seguintes porcentagens sobre o total de circuitos integrados utilizados nos módulos de memória produzidos em cada ano-calendário, de acordo com o seguinte cronograma:

I - para o ano de 2007: 60% (sessenta por cento);

II - para o ano de 2008: 40% (quarenta por cento); e

III - para o ano de 2009 em diante: 20% (vinte por cento).

§ 3º Adicionalmente ao parágrafo anterior, os circuitos integrados do tipo memória importados utilizados na montagem dos módulos de memória deverão ser marcados e testados no Brasil nos seguintes percentuais mínimos:

I - Marcação

a) para o ano de 2008: 60% (sessenta por cento); e

b) para o ano de 2009 em diante: 80% (oitenta por cento).

II - Teste

a) para o ano de 2008: 40% (quarenta por cento); e

b) para o ano de 2009 em diante: 80% (oitenta por cento).

§ 4º Os percentuais acima estabelecidos serão calculados em termos de quantidades dos totais de circuitos integrados do tipo memória importados.

§ 5º Opcionalmente, a empresa ficará dispensada das obrigações dispostas no §3º se utilizar os seguintes percentuais de placas de circuito impresso fabricados no Brasil, em relação ao volume total efetivo de módulos de memória produzidos no ano-calendário, conforme cronograma abaixo:

I - para o ano de 2008: 20% (vinte por cento); e

II - para o ano de 2009 em diante: 30% (trinta por cento).

Art. 6º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção para cada produto referido no caput do art. 1º desta Portaria poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto uma, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 7º Anualmente, as empresas fabricantes deverão encaminhar à Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, até 31 de março do ano posterior, relatório contendo informações referentes à utilização dos percentuais de circuitos integrados do tipo memória e de módulos de memória montados, importados, previstos nestes artigos desta Portaria.

Parágrafo único. O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, bem como o não cumprimento dos percentuais estabelecidos nesta Portaria caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas no § 9º do art. 2º da Lei no 8.387, de 1991 e no art. 33 do Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 8º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art. 9º Ficam revogadas as Portarias Interministeriais MIR/MICT/MCT nº 67, de 2 de maio de 1994 e MPO/MICT/MCT nº 45, de 19 de agosto de 1997.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL JORGE

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

SERGIO MACHADO REZENDE

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia